

Germanium PNP Transistor

GF147

20V / 10mA

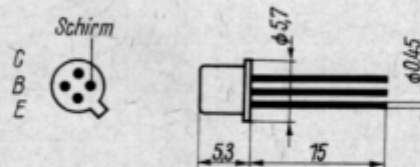
DATASHEET

OEM – RFT

Source: RFT Datenbuch Germanium Transistoren 71/72

GF 147

Germanium-pnp-Planartransistor der Bauform A 4/15 – 4a nach TGL 11 811 für Vor-, Misch- und Oszillatorstufen bis 900 MHz.



Masse ca. 0,4 g

Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung	$-U_{CBO}$	= 20 V
Kollektor-Emitter-Spannung	$-U_{CEO}$	= 15 V
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{EBO}$	= 0,3 V
Gesamtverlustleistung	P_{VL}	= 60 mW
Kollektorstrom	$-I_{CL}$	= 10 mA
Basisstrom	$-I_{BL}$	= 1 mA
Sperrschichttemperatur	θ_{jL}	= 90 °C
Umgebungstemperatur	θ_{aL}	= -25 °C bis +60 °C
Wärmewiderstand	R_{thja}	≙ 750 grd/W
Wärmewiderstand	R_{thjc}	≙ 350 grd/W

KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)

Röhrenwerk Anna Seghers Neuhaus



		Min.	Typ	Max.
Statische Kennwerte				
Kollektor-Basis-Reststrom	$-I_{CBO}$			8 μ A
$-U_{CB} = 20$ V				
$I_E = 0$				
Kollektor-Emitter-Reststrom	$-I_{CEO}$			500 μ A
$-U_{CE} = 15$ V				
$I_E = 0$				
Emitter-Basis-Reststrom	$-I_{EBO}$			100 μ A
$-U_{EB} = 0,3$ V				
$I_E = 0$				
Dynamische Kennwerte				
Übergangsfrequenz	f_T		650 MHz	
$-U_{CE} = 10$ V				
$-I_C = 2$ mA				
$f = 100$ MHz				
Kurzschlußstromverstärkung	h_{21E}	10		
$-U_{CE} = 10$ V				
$-I_C = 2$ mA				
Rauschmaß	F			6 dB
$-U_{CB} = 10$ V				
$-I_C = 2$ mA				
$f = 800$ MHz				
$R_g = 60 \Omega$				
Leistungsverstärkung	G_{pb}	11,5 dB		
$-U_{CE} = 10$ V				
$-I_C = 2$ mA				
$f = 800$ MHz				
$R_g = 2$ k Ω				
Bestellbeispiel für einen Transistor		Transistor GF 147		
		KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)		
		Röhrenwerk Anna Seghers Neuhaus		
		107		